

【NCS기반 채용 직무기술서(위촉연구원)】 **직할부서명: ICT창의연구소**

한국전자통신연구원		분 류 체 계	구분	연구원 자체 직무분석을 통해 도출
채용 분야	위촉연구원 (양자기술)		대분류	국가 지능화 융합 기술
채용 예정 인원	2 명		중분류	지능형 사이버 보안 및 신뢰 인프라 기술 연구
			소분류	해킹 불가능한 양자정보기반 신뢰 통신 인프라 기술 연구
기관 소개	한국전자통신연구원은 정보, 통신, 전자, 방송 및 관련 융합기술 분야의 핵심·미래기술을 연구개발하고, 성장동력 창출 및 성과확산을 통해 국가경제·사회 발전에 기여함			
전형 절차	서류전형 → 전공세미나(전공면접) → 임용			
직무 수행 내용	○ 반도체 양자점 기반 나노 포토닉스 소자 연구 ○ 양자 광원 (단일 광자, 얽힘 광자쌍) 극미세 분광 측정/분석 ○ 점 결함 (SiC, diamond, GaN 등) 기반 양자 광원 생성 연구 ○ 집적 광회로 (양자 광원 변환) 설계 및 광소자-실리콘 결함 소자 연구			
근무지	한국전자통신연구원 본원(대전광역시 유성구 가정로 218 한국전자통신연구원)			
일반 요건	연령, 성별	○ 연령: 무관 ○ 성별: 무관		
	기타	○ 한국전자통신연구원 인사내규상 아래의 결격사유에 해당하지 아니한 자 1. 국가공무원법 제33조(결격사유) 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 2. 법률에 의하여 공민권이 정지 또는 박탈된 자 3. 신체검사 결과 채용실격으로 판정된 자 4. 병역의무를 기피한 사실이 있는 자 5. 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제82조에 따라 취업 제한 기간 중에 있는 자 6. 다른 공공기관에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 채용이 취소된 자		
교육 요건	학력	○ 석·박사학위과정에 코스웍 중인 자로서 연구수행이 가능한 자 ※ 휴학생, 수료생 및 졸업생 지원 불가		
	전공	물리학, 반도체, 광학, 전기 전자, 신소재, 기계 등 관련 전공		
필요 지식	○ (양자점 나노 포토닉스) 광구조 설계, 공정 위한 반도체/고체물리 및 포토닉스 지식 ○ (양자광원 측정/분석) 양자 광원 다차원 광학 분석 위한 양자 광학 및 광학 기본 지식 ○ (점 결함 양자광원) 양자 역학, 양자 광학 등 양자 광학 연구 위한 기본 지식 ○ (광소자-광회로 결함) 반도체 제작 및 공정 위한 고체 물리 및 반도체 전반에 걸친 기본 지식			
필요 기술	○ (양자점 나노 포토닉스) FDTD, FEM 등 광학 시뮬레이션 설계 및 나노 공정 기술 ○ (양자광원 측정/분석) Resonant excitation, HBT, HOM, entangled photon 등 양자 광학 분석 기술 ○ (점 결함 양자광원) SiC, Diamond, GaN 등 고체 기반 점 결함 기반 양자 광원 생성/제어 기술 ○ (광소자-광회로 결함) Si, SiNx 기반 집적 광회로 설계/공정 및 III-V / 실리콘 광회로 결함 기술			

직무 수행 태도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 새로운 도전과 창의 ○ 선제적 변화 및 혁신 의지 ○ 연구협업을 위한 소통 및 협력
직업 기초 능력	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의사소통능력, 대인관계능력, 수리능력, 문제해결능력, 자기개발능력, 자원관리 능력, 조직이해능력, 정보능력, 기술능력, 직업윤리
기타	<ul style="list-style-type: none"> ○ 참고사이트 : www.ncs.go.kr ※ 위 내용은 NCS 미개발 직무로 한국전자통신연구원의 별도 직무분석을 통해 도출되었습니다. 향후 NCS 개발동향과 기관 주요사업 변경 등 내·외부 상황에 따라 변경될 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다. ○ 상기 직무는 지원자가 입사 시 수행할 대표 전문 분야의 직무이며, 입사 후 해당 직무 외 관련된 타 직무도 수행할 수 있습니다.